

# Varicap Diode

## **BA110**

8..12pF

# DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 71/72

## BA 110, BA 111, BA 112

**Diffundierte Silizium-Kapazitätsdioden**  
für elektronische Abstimm- und Nachstimmaltungen

Glasgehäuse JEDEC DO-7  
51 A 2 nach DIN 41 880  
Gewicht ca. 0,2 g  
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden  
diese Dioden gegurtet geliefert.  
Näheres siehe unter „Gurtung“.



### Grenzwerte

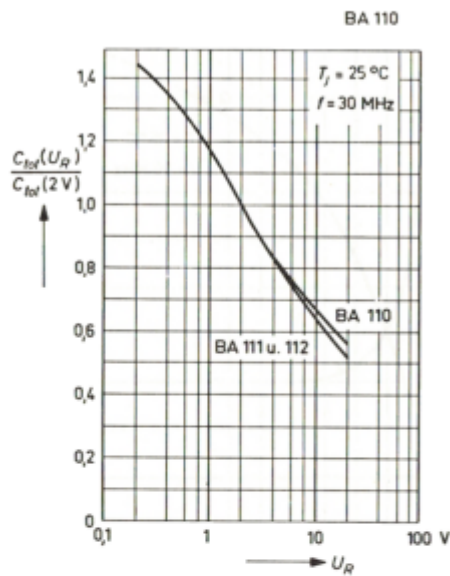
Sperrschichttemperatur	$T_j$	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	$T_s$	-50...+150	°C

### Kennwerte bei $T_j = 25\text{ °C}$

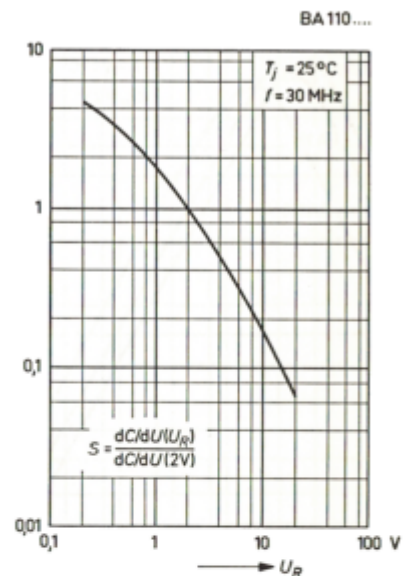
		BA 110	BA 111	BA 112		
Kapazität bei $f = 30\text{ MHz}$ , $U_R = 2\text{ V}$	$C_{tot}$	10 (8...12)	55 (45...65)	100 (80...120)	pF	
	$U_R = 4\text{ V}$	$C_{tot}$	8,3	45,7	83	pF
	$U_R = 10\text{ V}$	$C_{tot}$	6,8	34,7	63	pF
Serienwiderstand bei $f = 30\text{ MHz}$ , $U_R = 2\text{ V}$	$r_s$	1	0,5	0,5	$\Omega$	
Güte bei $f = 30\text{ MHz}$ , $U_R = 2\text{ V}$	$Q$	540	200	100		
Durchlaßspannung bei $I_F = 60\text{ mA}$	$U_F$	0,85 (<0,95)	0,85 (<0,95)	0,85 (<0,95)	V	
Sperrstrom bei $U_R = 10\text{ V}$	$I_R$	<50	<100	<200	nA	
Durchbruchspannung	$U_{(BR)R}$	>30	>20	>20	V	

# BA 110, BA 111, BA 112

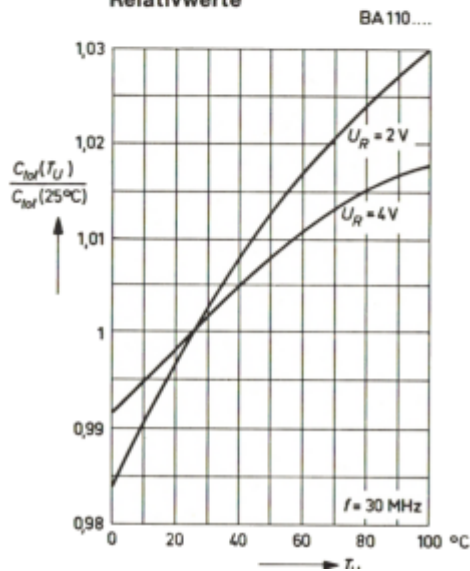
**Kapazität  
in Abhängigkeit von der  
Sperrspannung  
Relativwerte**



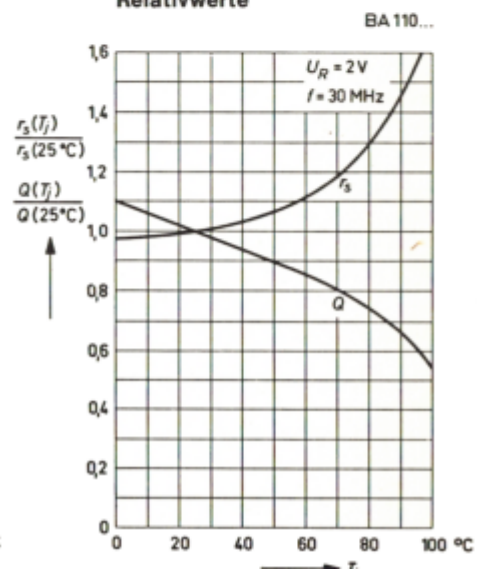
**Steilheit  
in Abhängigkeit von der  
Sperrspannung  
Relativwerte**



**Kapazität  
in Abhängigkeit von der  
Umgebungstemperatur  
Relativwerte**

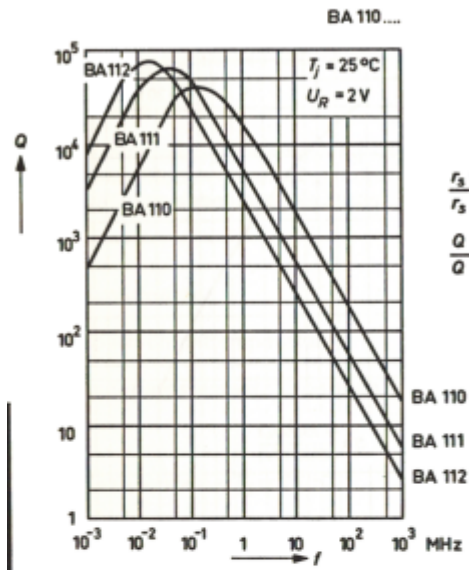


**Serienwiderstand und Güte  
in Abhängigkeit von der  
Sperrschichttemperatur  
Relativwerte**



## BA 110, BA 111, BA 112

**Güte**  
In Abhängigkeit von der  
Frequenz



**Serienwiderstand und Güte**  
in Abhängigkeit von der  
Sperrspannung  
Relativwerte

